

砷化镓（GaAs）晶圆规格	
直径	50 ~ 150MM ± 0.25MM(2" 3" 4" 6")
材料	单晶砷化镓
晶体生长方法	VGF / LEC
晶向	<100> / <111>
晶向	偏角 $\alpha \pm \beta$ 0; 偏角 α 及精度 β 可按客户需求定制
掺杂剂	Undoped / Zn / Si / Te
厚度	350 ± 25um / 550 ± 25um / 625 ± 25um
迁移率	1500 ~ 3000 / 3000 ~ 5000 cm ² / V·sec
主定位边	<0-1-1> ± 0.5deg, 16 ±1.0mm / 22±1.0mm / 32.5±1.0mm
副定位边	<0-1-1> ± 5.0 deg, 8 ±1.0mm / 11±1.0mm / 18±1.0mm
正面	Prime 级, 抛光, 外延就绪
背面	抛光 / 研磨 / 蚀刻
Epi-ready	Yes